

Information 10/65

Feldeffekttransistoren

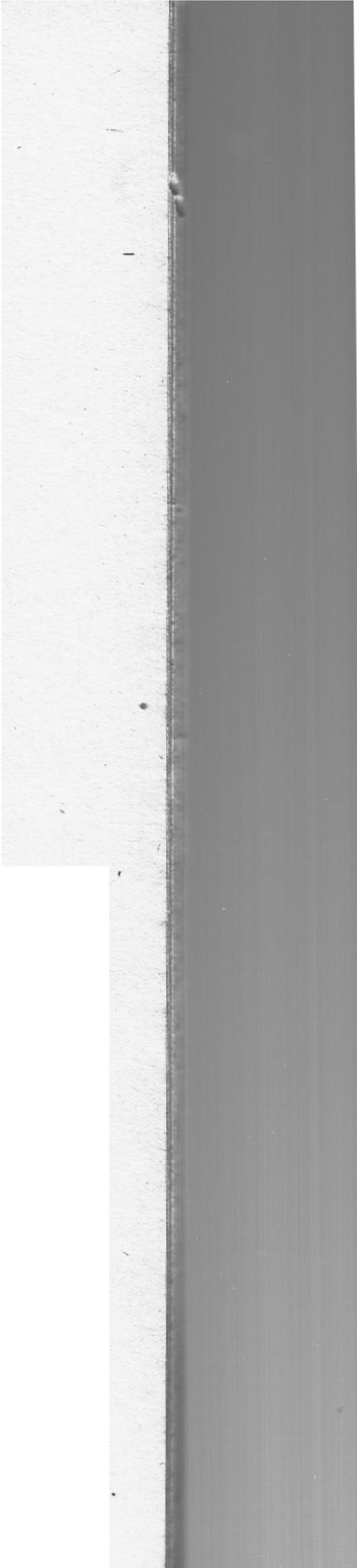
der Arbeitsgruppe

Entwicklungstendenzen der Forschungsleitstelle

im VEB Halbleiterwerk Frankfurt/Oder – Werkteil Stahnsdorf

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung	3
2. Geschichtliches	4
3. Wirkungsweise der Feldeffekttransistoren	5
3.1 Die verwendeten Bezeichnungen	5
3.2 Der Sperrschicht-Feldeffekttransistor	6
3.3 Der Metalloxyd-Feldeffekttransistor	7
4. Eigenschaften und Anwendungen	14
4.1 Allgemeine Eigenschaften	14
4.2 Kenndaten von 10 Feldeffekttransistoren und einem logischen Bauelement	15
4.3 Einige Anwendungen	20
5. Produktion und Produzenten	21
6. Standpunkt einiger DDR-Betriebe zum Feldeffekttransistor	25
7. Literaturverzeichnis	26





esa Information wurde von den Physikstudenten H.- **Fehdler** c 3. Rogaschewski im Auftrag der Forschungsleitstelle

. Entwicklungstendenzen) des Halbleiterwerkes Frankfurt/ e., Werkteil Stahnsdorf Ruhlsdorßer Weg_g als Praktikumsbeit angefertigt.